

### 电力半导体晶闸管模块说明书

#### 一、特性

- 1、芯片采用沟槽氮化硅玻璃烧结工艺。
- 2、通态压降低,功耗小。
- 3、高温 175℃下反向漏电流小。
- 4、浪涌电流能力强。
- 5、塑料灌封结构,安装方便,可靠性高。
- 6、热性能好。

#### 二、质量等级

- 1、企军标 JP、JT: GJB33A-97
- 2、七专 G: QZJ840611A
- 3、普军 J: 参考 QZJ840611A 执行。
- 三、可控硅模块额定值和特性参数



表1: 可控硅模块额定值和特性参数

电参数	I <sub>T(AV)</sub>	V <sub>DRM</sub> /V <sub>RRM</sub>	I <sub>DRM</sub> ,	$V_{TM}$	$T_{jM}$	$I_{GT}$	$V_{GT}$	R <sub>jc</sub>	产品外形图	备注
产品型号	A	V	mA	V	°C	mA	V	°C/W		
	25	400~1800	€2	≤1.4	125	≤150	€2	0.78	图 9-1	
	40	400~1800	€2	≤1.4	125	≤150	€2	0.55	图 9-1	
	55	400~1800	€2	≤1.4	125	≤150	€2	0.53	图 9-1	
	70	400~1800	€2	≤1.4	125	≤150	€2	0.41	图 9-1	产品详
MTC	90	400~1800	€2	≤1.4	125	≤150	€2	0.28	图 9-1	细电特
MTA	110	400~1800	€2	≤1.4	125	≤150	€2	0.25	图 9-1	性、外
MTK	130	400~1800	€3	≤1.4	125	≤150	€2	0.20	图 9-2	形图以
MTX	160	400~1800	€3	≤1.4	125	≤150	€2	0.17	图 9-3	各产品
MFC	180	400~1800	€3	≤1.4	125	≤150	≤2	0.16	图 9-3	的技术
	200	400~1800	≪4	≤1.4	125	≤150	€2	0.14	图 9-3	规格书
	250	400~1800	≪4	≤1.4	125	≤150	≤2	0.12	图 9-3	为准。
	300	400~1800	€5	≤1.4	125	≤150	€2	0.10	图 9-4	
	500	400~1800	€5	≤1.4	125	≤150	€2	0.065	图 9-5	



#### 四、电力半导体晶闸管模块电连接方式:

表 2: M 系列功率模块电联结形式表、可控硅模块 电连接形式表

型号	MTC	MTA	MTK	MTX	
电联结形式	« ►/°? ►/°	Na P → Co	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		

表3: 混合模块电联结型式表

型号	MFC (C)	MFC (A)	MFK	MFA	
电联结形式	5 P 5 0		ه ا اماح		

- 五、本系列模块的电极与壳体绝缘电压均大于 2500V。
- 六、产品安装注意事项,详见本手册第116页。



### 附图 9: 电力半导体晶闸管模块外形图

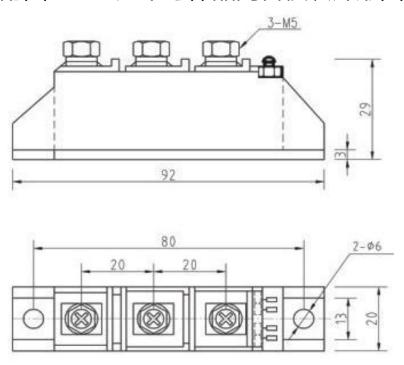


图 9-1: 晶闸管模块外形图 1

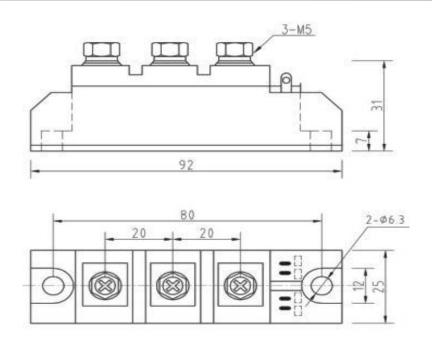


图 9-2: 晶闸管模块外形图 2



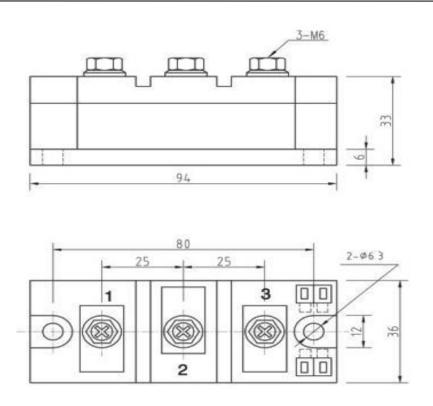


图 9-3: 晶闸管模块外形图 3

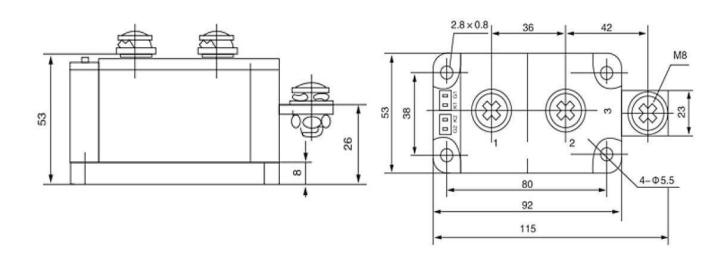


图 9-4: 晶闸管模块外形图 4



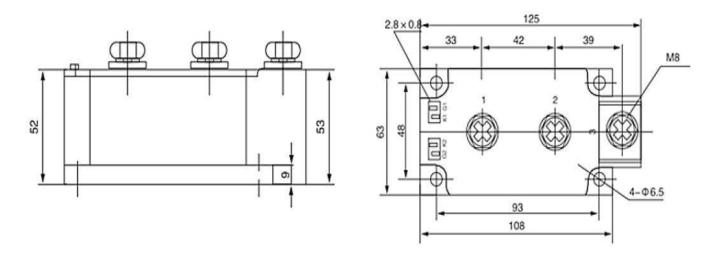


图 9-5: 晶闸管模块外形图 5